

# ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

# ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ VLSI

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΈΤΟΣ 2021-2022

ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΜ 1075217 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:1080453

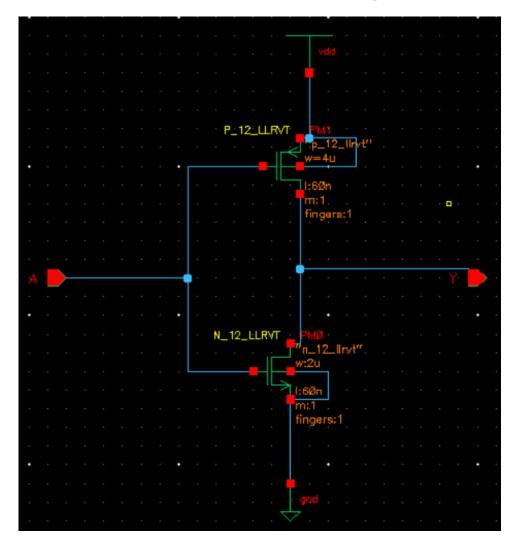
# ΑΣΚΗΣΗ 1

## ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Σε αυτή την άσκηση καλούμαστε να κατασκευάσουμε μια πύλη NOT με Cmos τεχνολογία. Μετά θα κάνουμε μια transient ανάλυση έτσι ώστε να πάρουμε χρόνους ανόδου και καθόδου όπως επίσης και χρόνο διάδοσης. Έπειτα θα κάνουμε μια DC ανάλυση στην τάση εξόδου ως προς την τάση εισόδου και να βρούμε από εκεί κάποιες σημαντικές παραμέτρους όπως  $V_{\text{IH}}, V_{\text{OH}}, V_{\text{OH}}, V_{\text{OL}}$ .

Σχεδιάσαμε το κύκλωμα όπως είναι φυσικό με ένα pmos(pullup) και ένα nmos(pulldown) τρανζίστορ. Βάλαμε τάση τροφοδοσίας μια πηγή συνεχούς τάσης 1V και για είσοδο μια παλμοσειρά με μέγιστη τάση 1V και ελάχιστη 0V. Επίσης βάλαμε χρόνο ανόδου και χρόνο καθόδου 10nsec για να έρθουμε πιο κοντά στην πραγματικότητα σαν να έρχεται το σήμα από έξοδο μιας άλλης πύλης. Τέλος βάλαμε και έναν πυκνωτή στην έξοδο για να μπει μια χωρητικότητα σαν να οδηγούμε μια άλλη πύλη.

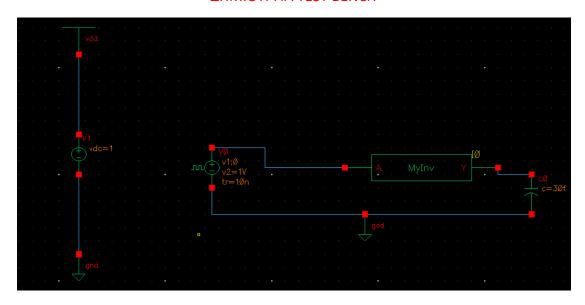
## ΣΧΗΜΑΤΙΚΉ ANAΠΑΡΑΣΤΑΣΗ INVERTER1 ME FINGER 1



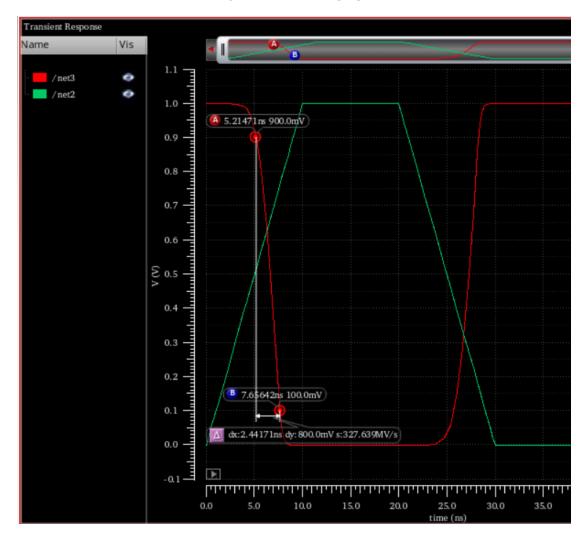
## ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ INVERTER

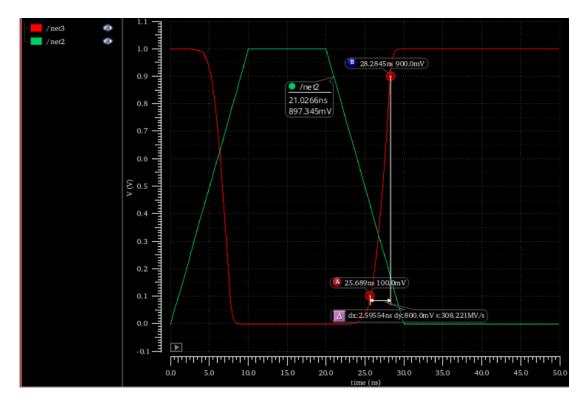


## ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ TEST BENCH



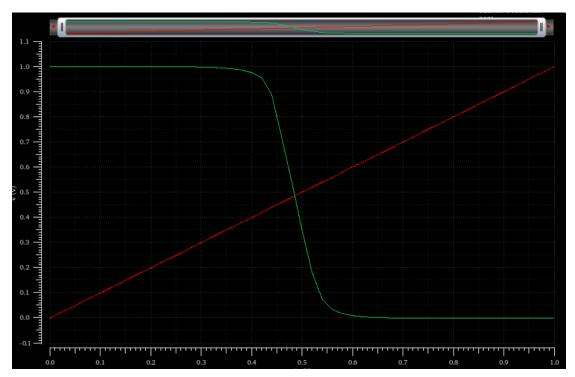
## RISE-FALL TIME EΞOΔΟΥ





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το fall time και rise time υπολογίστηκαν από τη διαφορά χρόνου από την στιγμή που η τάση εξόδου ήταν στο 90% έως την στιγμή που ήταν στο 10% και αντίθετα.

Πράσινο: τάση εξόδου κόκκινο :συνάρτηση χ=γ

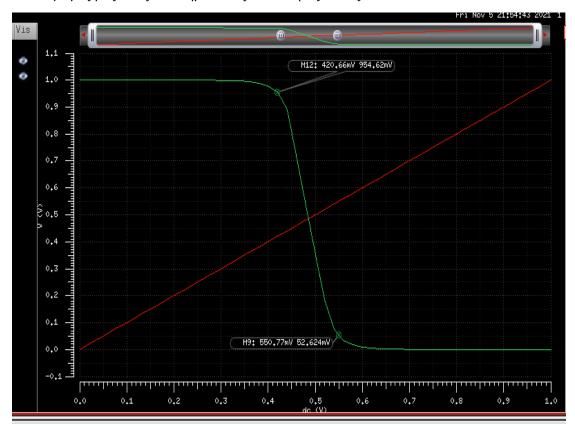


Από την γραφική παράσταση μπορούμε να βρούμε σημαντικούς παραμέτρους όπως VIH, VOH, VIL, VIH τάση μετάβασης τάση μετάβασης είναι η τάση που η τάση εξόδου και εισόδου έχουν την ίδια τιμή. Είναι μια κατάσταση που δεν θέλουμε να παραμείνουμε για αρκετά nsec διότι άγουν και τα δυο τρανζίστορ του αντιστροφέα σε εκείνη την χρονική στιγμή.

Οι τάσεις VIH, VOH, VIL, VIH υπολογίζονται από τα σημεία της γραφικής παράστασης που η παράγωγος θα είναι ίση με -1.



Υπολογισμός βάζοντας δυο σημεία στις κατάλληλες θέσεις:



- $\bullet \qquad V_{IL}=420,\!66m$
- $V_{IH} = 550,77 \text{mV}$
- $V_{OL} = 52,62 \text{mV}$
- $V_{OH} = 954,62 \text{mV}$

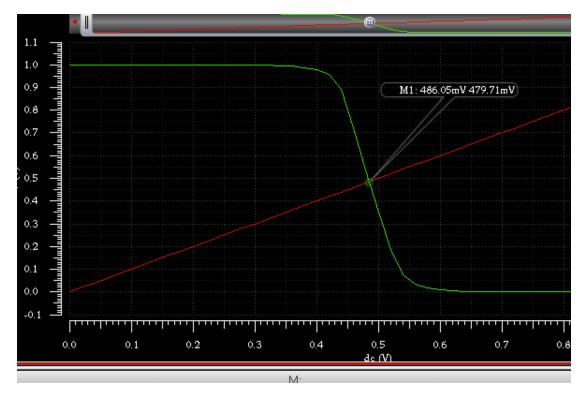
Εύκολα πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τα περιθώρια θορύβου:

## Περιθώρια θορύβου

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 954,62 \text{mV} - 550,77 \text{mV} = 403,85 \text{mV}$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 420,66 mV - 52,62 mV = 368,04 mV$$

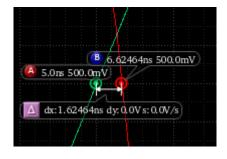
Τάση μετάβασης = 0,48V



Το διάστημα όπου ο αντιστροφέας είναι στην φάση μετάβασης είναι όταν η τάση εισόδου είναι αναμεσά από  $V_{\text{IL}}$  και  $V_{\text{IH}}$ .

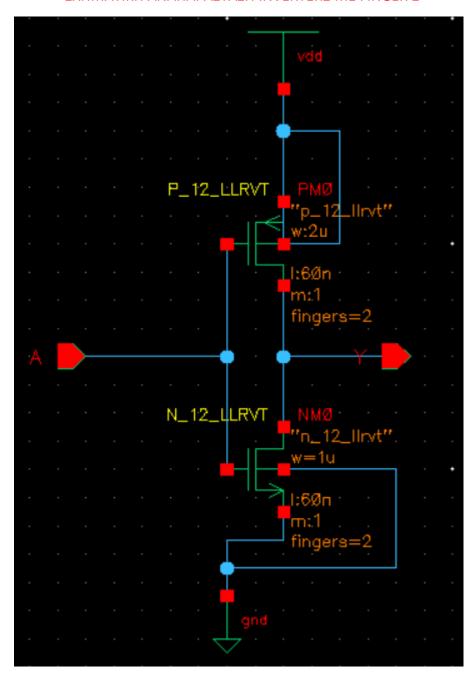
## ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει η έξοδος στο 50% του τελικού επιπέδου εξόδου, όταν η είσοδος αλλάζει στο 50% του τελικού επιπέδου εισόδου.

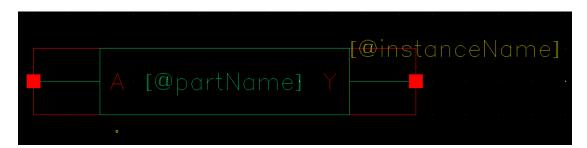


## ΕΡΩΤΗΜΑ 2

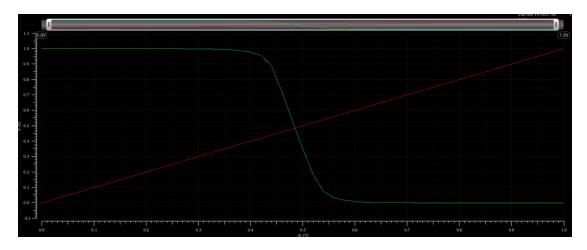
## ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ INVERTER2 ME FINGER 2



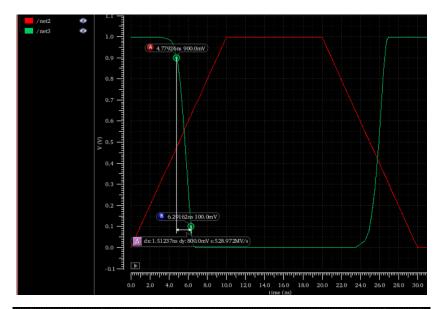
## ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ INVERTER

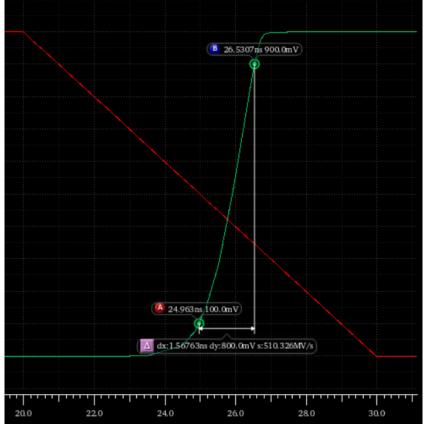


## ΑΝΑΛΥΣΗ DC ΕΞΟΔΩΝ

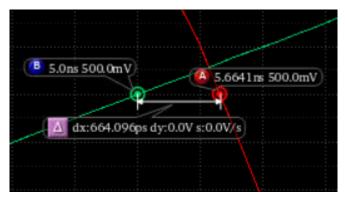


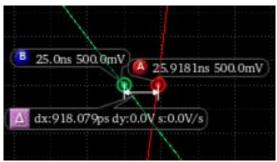
## RISE-FALL TIME EΞΟΔΟΥ





#### ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ





	INVERTER 1	<b>INVERTER 2</b>
$t_f$	2.4417ns	1.51237ns
$t_r$	2.59554ns	1.56763ns
$t_{phl}$	1.6246ns	664.096ps
$t_{plh}$	2.2921ns	918.079ps

#### ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αλλαγή που κάναμε ήταν να κάνουμε τα τρανζίστορ να έχουν 2 fingers. Ο αριθμός των fingers τότε η αντίσταση μειώνεται καθώς η πύλη συμπεριφέρεται τώρα ως 2 παράλληλες αντιστάσεις και έτσι η συνολική αντίσταση μειώνεται. Έτσι καταφέραμε να κατασκευάσουμε ένα inverter το οποίο και μεταβάλλει την κατάστασή του πιο γρήγορα (κατά 1 ns περίπου) και ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στις αλλαγές που δέχεται στην είσοδο (κατά 1 ns περίπου επίσης).

Σε αυτή την άσκηση ήταν μια γνωριμία με το πρόγραμμα cadence και τις δυνατότητες του. Με τις αναλύσεις transient και DC είδαμε αρκετά χαρακτηριστικά του αντιστροφεα που κατασκευάσαμε.

# ΑΣΚΗΣΗ 2

Σε αυτήν την άσκηση καλούμαστε να σχεδιάσουμε μια πύλη Nand δυο εισόδων με τεχνολογία Cmos. Χρειαζόμαστε συνολικά 4 τρανζίστορ δυο nmos(pull down)και δυο pmos(pullup).

Οι διαστάσεις αυτών καθορίστηκαν ρητά από την εκφώνηση:

Nmos: μήκος καναλιού 60nm πλάτος καναλιού 300nm

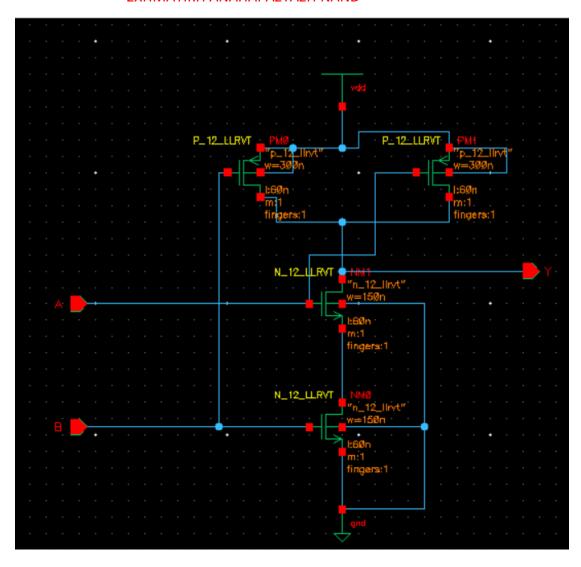
Pmos: μήκος καναλιού 60nm πλάτος καναλιού 150nm

Για να έχουμε συμμετρία θα μπορούσαμε να είχαμε ίδιες διαστάσεις στα τρανζίστορ αφού στο pulldown έχουμε 2 τρανζίστορ σε σειρά ενώ στο pullup δυο παράλληλα.

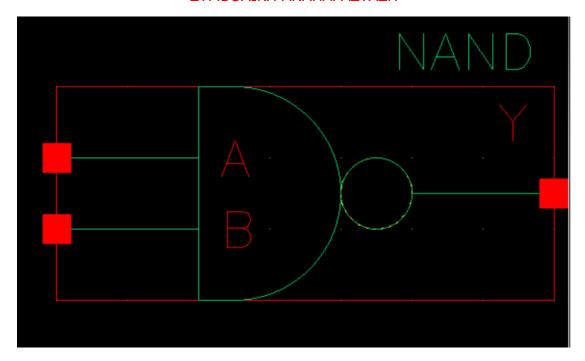
Βάλαμε τάση τροφοδοσίας 1V και σε κάθε είσοδο βάλαμε μια παλμοσειρά για να τσεκάρουμε το κύκλωμα μας. Για να πάρουμε όλες τις δυνατές εισόδους βάλαμε στην μια είσοδο υποδιπλάσια περίοδο από την άλλη.

#### ΕΡΩΤΗΜΑ 1

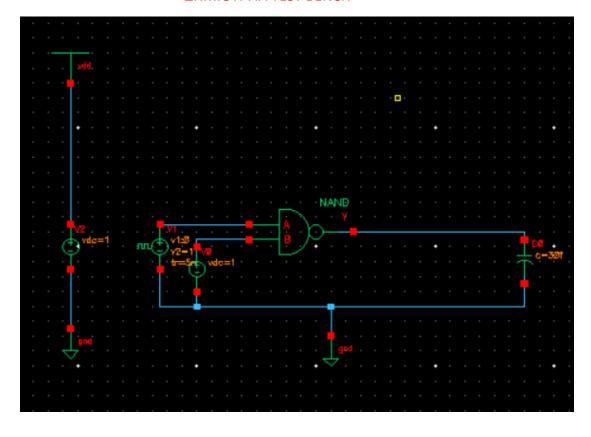
## ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ NAND



# ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ TEST BENCH

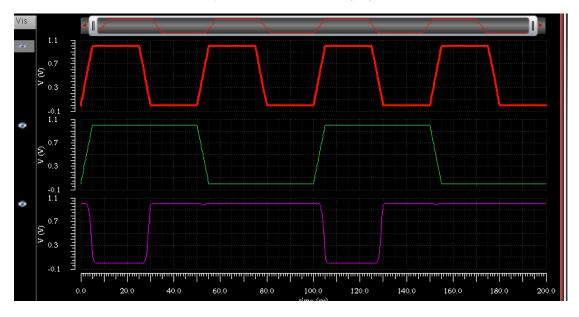


## TRANSIENT ΑΝΑΛΥΣΗ

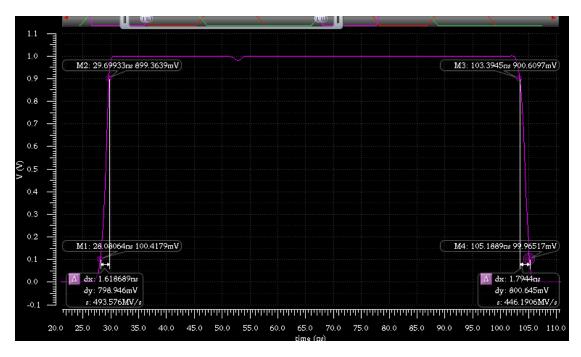
Κόκκινο :είσοδος Α



μωβ :έξοδος πύλης



## ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΥ



- Χρόνος καθόδου= 1,794nsec
- Χρόνος ανόδου= 1,6186nsec

Υπολογισμός από calculator:

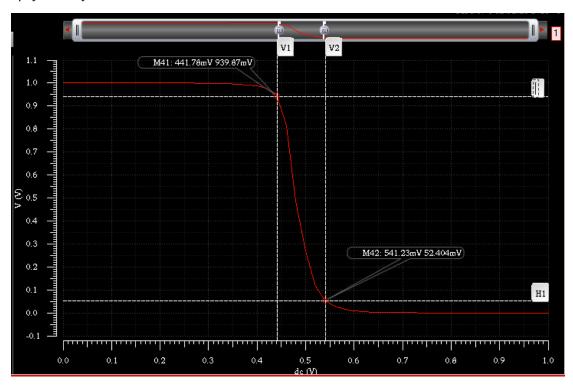
	AlieMay 0.3 AAI	E		
Expression   Value   time (s)   (	clipX(v(9 ) (V)	Expression	Value	
1 riseTime(v("/n 1.623E-9 0.000	1.000	fallTime(clipX(	1.782E-9	

Εδώ βλέπουμε την ακρίβεια διότι με την προηγούμενη μέθοδο δεν είχαμε ακρίβεια με το να μαρκάρουμε πάνω στην γραφική παράσταση.

#### ΑΝΑΛΥΣΗ DC ΕΞΟΔΩΝ

Στην ανάλυση αυτή θα δούμε την έξοδο συνάρτηση της τάσης εισόδου.

Επιλέχθηκαν σημεία που η παράγωγος της συνάρτησης είναι -1. Λόγω ότι έχουμε δυο εισόδους στην πρώτη περίπτωση έγινε με την μια είσοδο στο λογικό 1 και την άλλη να είναι στον οριζόντιο άξονα.



- $V_{IL} = 441,76 \text{mV}$
- $V_{IH} = 541,23 \text{mV}$
- $V_{OL} = 52,404 \text{mV}$
- $V_{OH} = 939,67 \text{mV}$

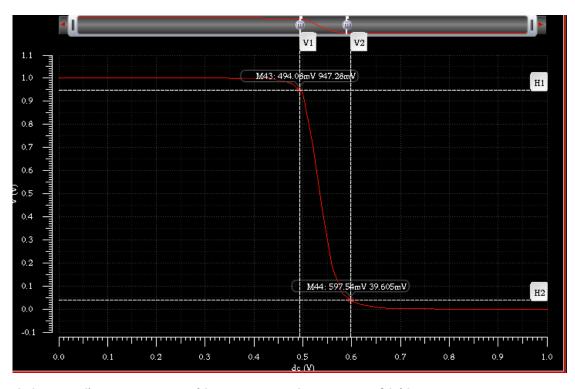
Εύκολα πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τα περιθώρια θορύβου.

# Περιθώρια θορύβου

 $NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 939,67 \text{mV} - 541,23 \text{mV} = 398,44 \text{mV}$ 

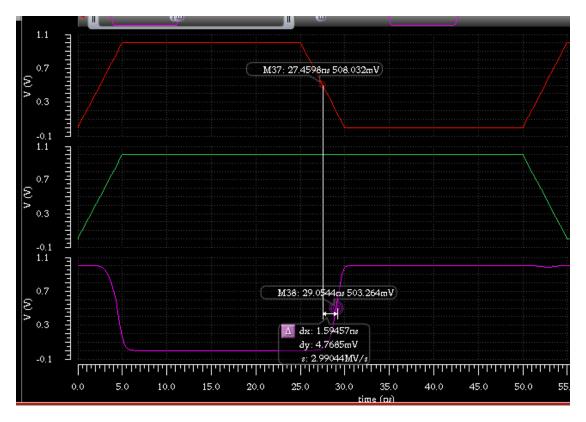
 $NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 441,76 \text{mV} - 52,404 \text{mV} = 389,35 \text{mV}$ 

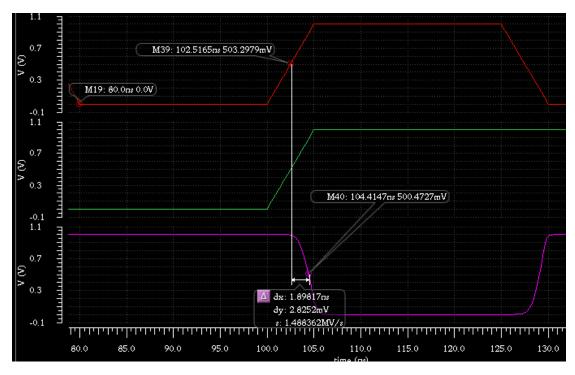
Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε και τις δυο εισόδους να αλλάζουν ταυτόχρονα χωρίς δηλαδή μια το ένα τρανζίστορ να είναι <<έτοιμο>>.



Οι διαφορές ίσως οφείλονται σε μη τοποθέτηση των σημείων στην ακριβή θέση.

## ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

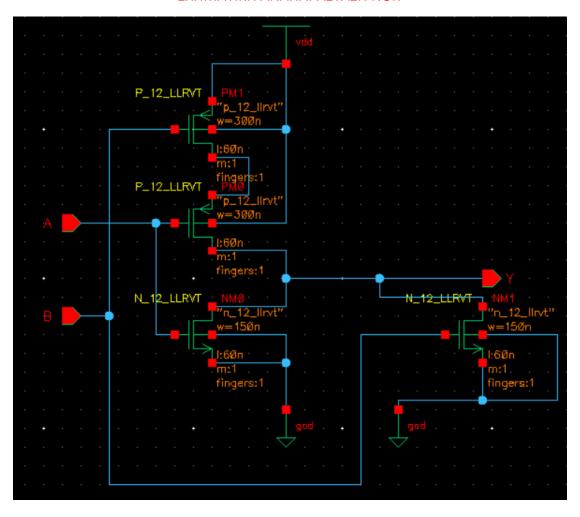




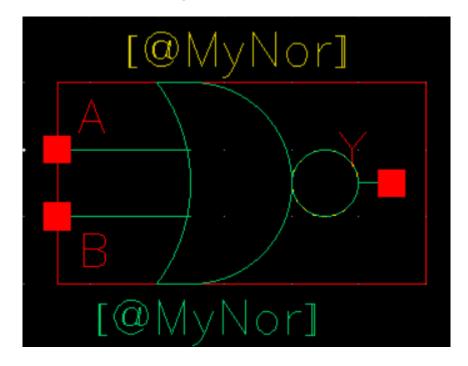
Οπότε η μέση καθυστέρηση διάδοσης υπολογίζετε από τον τύπο (TpLH+TpHL)/2 = (1.59457 nsec + 1.69817 nsec)/2 = 1,64637 nsec

# ΕΡΩΤΗΜΑ 2

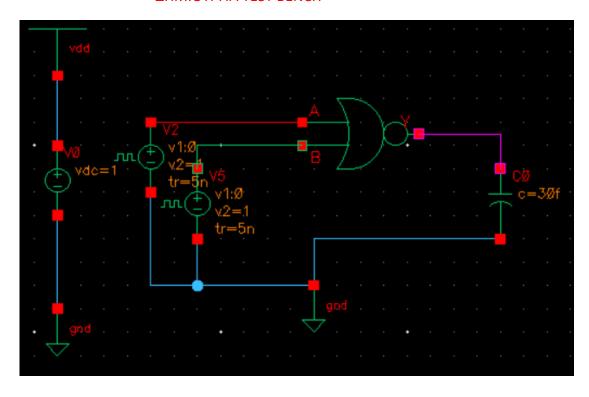
## ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ NOR



## ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

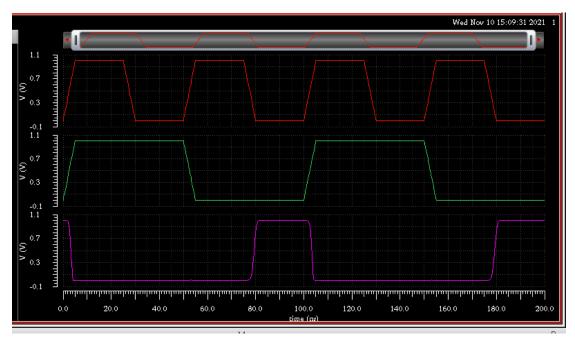


## ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ TEST BENCH

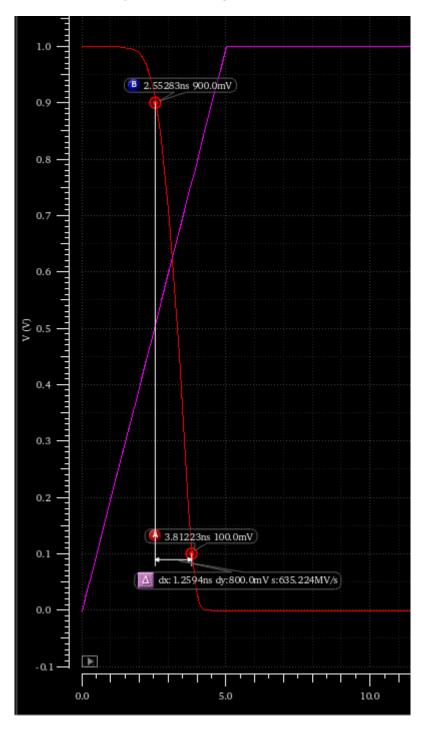


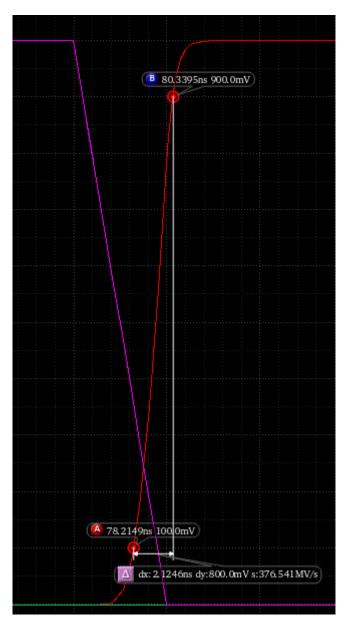
## TRANSIENT ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Κόκκινο :είσοδος Α πράσινο :είσοδος Β μοβ : έξοδος πύλης



## RISE-FALL TIME ΕΞΟΔΩΝ

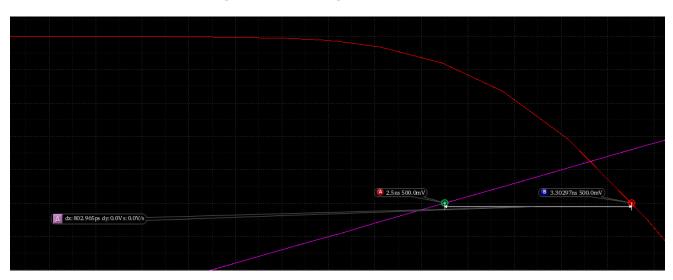


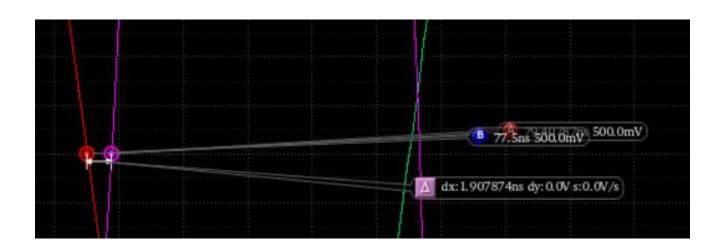


Εικόνα από calculator για μεγαλύτερη ακρίβεια:



## ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

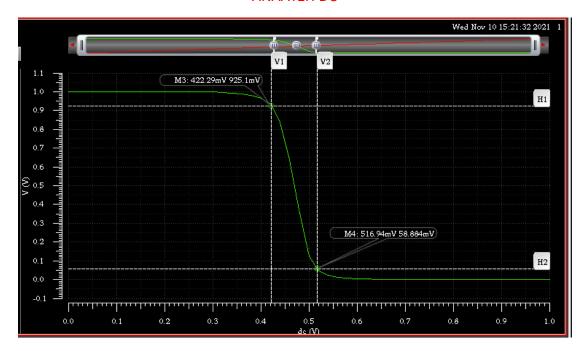




	NAND	NOR
t <sub>F</sub>	2.76659ns	1.2594ns
t <sub>R</sub>	2.61019ns	2.1246ns
t <sub>PHL</sub>	1.5144ns	802.965ps
t <sub>PHL</sub>	802.965ps	1.90787ns

Λόγω της ασσυμετρίας σε αγωγιμότητα για το pullup και τα pulldown κύκλωμα έχουμε αυτές τις διαφορές στους χρόνους  $t_{PHL}$ ,  $t_{PHL}$ . Οπότε η μέση καθυστέρηση διάδοσης υπολογίζετε από τον τύπο (TpHL+TpLH)/2=(802.965psec+1.90787 nsec)/2=1.3554175 nanoseconds

## ΑΝΑΛΥΣΗ DC



- $V_{IL} = 422,29 \text{mV}$
- $V_{IH} = 516,94 \text{mV}$
- $V_{OL} = 58,66 \text{mV}$
- $V_{OH} = 925,10 \text{mV}$

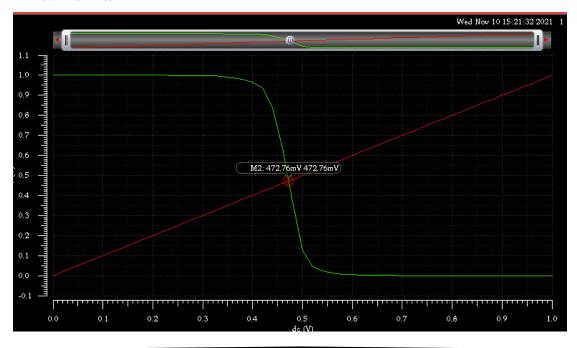
Εύκολα πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τα περιθώρια θορύβου:

## Περιθώρια θορύβου

 $NM_{\rm H}\!=V_{\rm OH}\text{-}V_{\rm IH}=925,\!10mV\text{-}516,\!94mV=408,\!16mV$ 

 $NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 422,29 \text{mV} - 58,66 \text{mV} = 363,63 \text{Mv}$ 

Τάση μετάβασης 472,76mV:



## Συμπεράσματα

Η άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Είδαμε ότι σε πύλες με παραπάνω από μια εισόδους θα πρέπει να δείξουμε στην DC ανάλυση μια προσοχή διότι θα πρέπει αν εξετάσουμε όλες τις πιθανούς συνδυασμούς εισόδων .

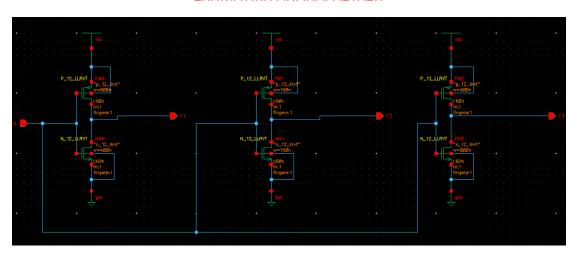
## ΑΣΚΗΣΗ 3

Σε αυτή την άσκηση καλούμαστε να σχεδιάσουμε τρεις αντιστροφείς με τεχνολογία cmos.

Όπου κάθε ένας αντιστροφέας έχει διαφορετικές διαστάσεις όσο αναφορά το πλάτος των τρανζίστορ. Έτσι με αυτήν την τακτική θα καταφέρουμε να δείξουμε πόσο καθοριστικό ρόλο έχουν οι διαστάσεις των τρανζίστορ και θα μελετήσουμε τι συμβαίνει ανάλογα με τον λόγο bn/bp. Θα κάνουμε το πείραμα με χωρητικότητα πυκνωτή 1f και 5f και θα μελετήσουμε τις όποιες διαφορές.

#### ΕΡΩΤΗΜΑ 1

#### ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



Αντιστροφεας με έξοδο Υ1:

**nmos**: <u>πλάτος 400nm</u> μήκος 60nm

**pmos**: πλάτος 800nm μήκος 60nm

Αντιστροφεας με έξοδο Υ2:

**nmos**: <u>πλάτος 150nm μήκος 60nm</u>

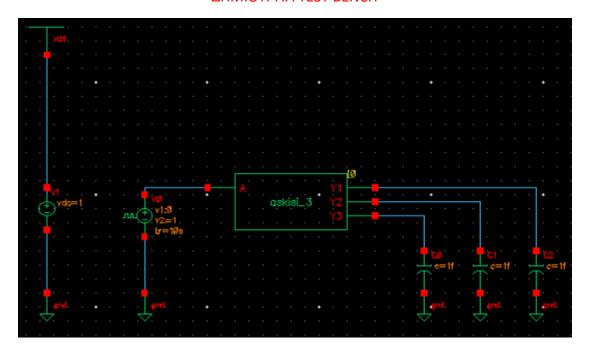
**pmos**: πλάτος 150nm μήκος 60nm

## Αντιστροφεας με έξοδο Υ3:

nmos: πλάτος 800nm μήκος 60nm

pmos: πλάτος 400nm μήκος 60nm

## ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ TEST BENCH



## TRANSIENT ANAΛΥΣΗ

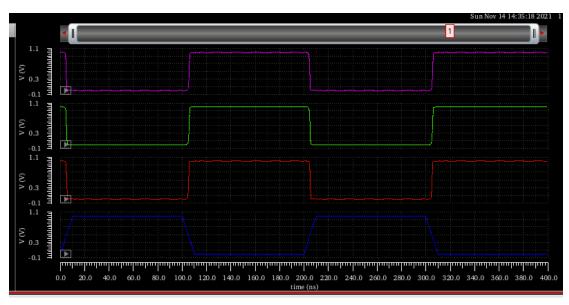
Σε αυτή την άσκηση καλούμαστε να σχεδιάσουμε τρεις αντιστροφείς με τεχνολογία cmos.

Οπου κάθε ένας αντιστροφεας έχει διαφορετικές διαστάσεις όσο αναφορά το πλάτος των τρανζίστορ. Έτσι με αυτήν την τακτική θα καταφέρουμε να δείξουμε πόσο καθοριστικό ρόλο έχουν οι διαστάσεις των τρανζίστορ και θα μελετήσουμε τι συμβαίνει ανάλογα με τον λόγο bn/bp. Θα κάνουμε το πείραμα με χωρητικότητα πυκνωτή 1f και 5f και θα μελετήσουμε τις όποιες διαφορές.

Μπλε: εισοδος κοκκινο: Υ1

πρασινο:Υ2

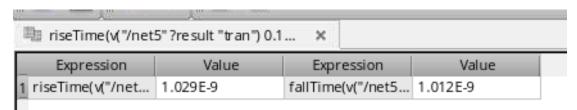
μοβ:Υ3



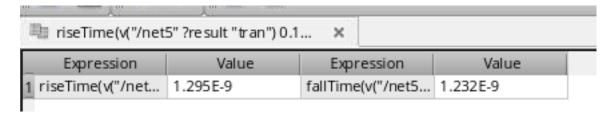
#### ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΥ

Για να αποφύγουμε την κούραση του αναγνώστη παρουσιάζουμε μετρήσεις μόνο από calculator:

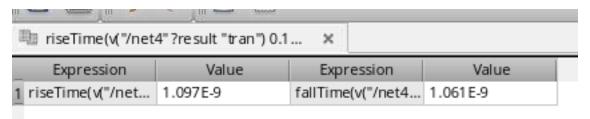
## Αντιστροφεας με έξοδο Υ1 και πυκνωτή c=1fF :



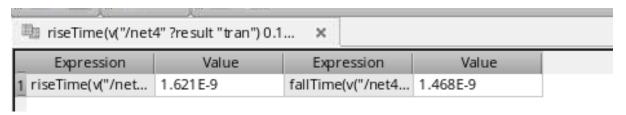
### Αντιστροφεας με έξοδο Υ1 και πυκνωτή c=5fF:



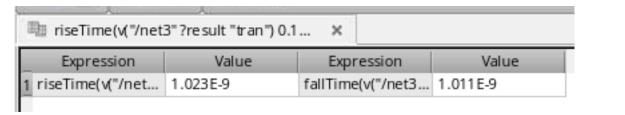
## Αντιστροφεας με έξοδο Υ2 και πυκνωτή c=1fF:



## Αντιστροφεας με έξοδο Υ2 και πυκνωτή c=5fF:



Αντιστροφεας με έξοδο Y3 και πυκνωτή c=1fF:



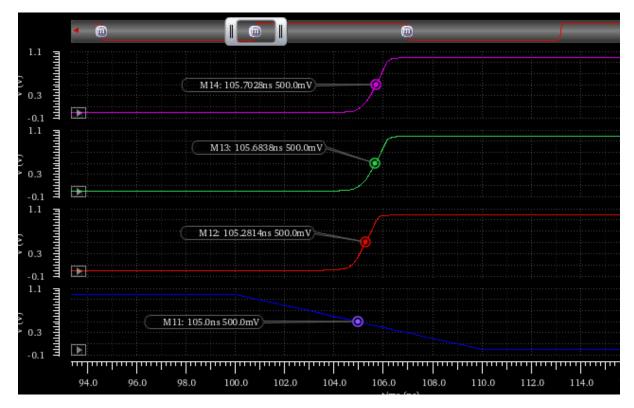
Αντιστροφεας με έξοδο Υ2 και πυκνωτή c=5fF:

riseTime(v("/net3" ?re sult "tran") 0.1 ×				
_ Expression	Value	Expression	Value	
1 riseTime(v("/net	1.328E-9	fallTime(v("/net3	1.218E-9	

### ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Παρατηρούμε πως με πυκνωτή με χωρητικότητα 5fF οι χρόνοι ανόδου – καθόδου έχουν αυξηθεί κάτι αναμενόμενο διότι κατά την φόρτιση της εξόδου έχουμε να φορτίσουμε μεγαλύτερη χωρητικότητα και κατά την αποφόρτιση της εξόδου έχουμε να αποφορτίσουμε μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Μπλε: εισοδος κοκκινο: Υ1 πρασινο: Υ2 μοβ: Υ3



Y1:T<sub>P</sub>LH = 0,281nsec

Y2:T<sub>P</sub>LH = 0,683nsec

 $Y:3:T_PLH = 0,702nsec$ 

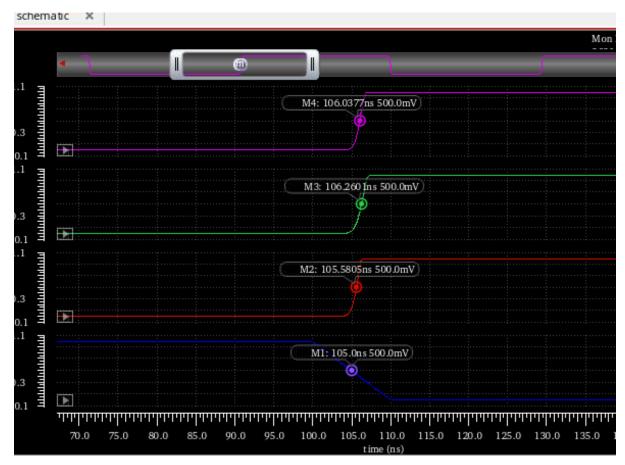
Βλέπουμε πως η έξοδος Υ1 του αντιστροφέα που έχει μεγαλύτερο πλάτος τρανζίστορ pmos έχει και μικρότερο χρόνο καθυστέρησης διάδοσης **T**<sub>P</sub>**LH**.

Η έξοδος του αντιστροφεα με τα τρανζίστορ με το μικρότερες διαστάσεις έχει τον επόμενο καλύτερο χρόνο λόγω των μικρών διαστάσεων.

Τέλος με μεγαλύτερο χρόνο έρχεται ο αντιστροφεας με έξοδο Υ3 λόγω ότι έχουμε μεγάλη διαφορά σε διαστάσεις από τα προβλεπόμενα ανάμεσα στο pullup και pulldown κύκλωμα.

## ΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ (C=5Ff)

Μπλε: εισοδος κοκκινο: Υ1 πρασινο: Υ2 μωβ: Υ3



Y1:T<sub>P</sub>LH = 0,580nsec

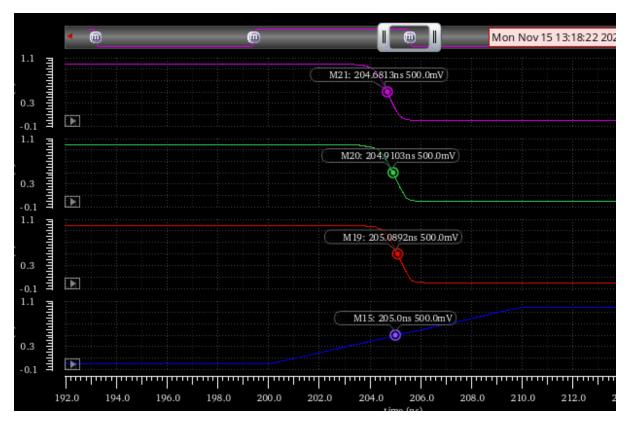
Y2:T<sub>P</sub>LH = 1,126nsec

Y:3:T<sub>P</sub>LH = 1,037nsec

Παρατηρούμε ότι οι χρόνοι αυξήθηκαν λόγω ότι αυξήσαμε την χωρητικότητα εξόδου.

Θέλουμε περισσότερο χρόνο για να φορτίσουμε την χωρητικότητα εξόδου.





 $Y1:T_PHL = 0,089$ nsec

Y2:T<sub>P</sub>HL = -0,090nsec

## Y:3:T<sub>P</sub>HL = -0,319nsec ΠΡΟΣΟΧΗ APNHTIKH TIMH!!!

Βλέπουμε πως για Y2 και Y3 έχουμε αρνητικέ τιμές . Αυτό συμβαίνει διότι όπως θα δούμε παρακάτω η τάση μετάβασης για αυτούς τους δυο αντιστροφείς είναι εκτοπισμένες αρκετά από το  $0.5 \rm V$  λόγω της μη συμμετρίας στην αγωγιμότητα στο pullup και pulldown κυκλώματος. Μπλε: εισοδος κοκκινο: Υ1 πρασινο: Υ2 μοβ: Υ3



Y1:T<sub>P</sub>HL = 0,376nsec

Y2:T<sub>P</sub>HL = 0,393nsec

 $Y:3:T_PHL = -0,050nsec$ 

Παρατηρούμε ότι οι χρόνοι αυξήθηκαν λόγω ότι αυξήσαμε την χωρητικότητα εξόδου.

Θέλουμε περισσότερο χρόνο για να αποφορτίσουμε την χωρητικότητα εξόδου.

## DC ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ 1fF

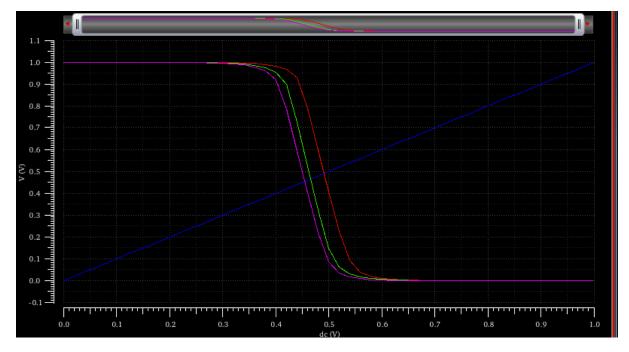
Στην ανάλυση αυτή θα δούμε την έξοδο συνάρτηση της τάσης εισόδου.

Βλέπουμε και τις τρεις εξόδους και παρατηρούμε ότι είναι διαφορετικές.

Αλλάζουν κατάσταση σε λίγο διαφορετικές τάσεις εισόδου.

Αυτό είναι λογικό διότι οι διαστάσεις των αντιστροφέων είναι διαφορετικές.





#### Αντιστροφεας με εξοδο Υ1:

nmos: πλάτος 400nm μήκος 60nm

**pmos**: πλάτος 800nm μήκος 60nm

Βλέπουμε στην τάση εξόδου όταν η είσοδος από 1V πάει προς 0V είναι η πρώτη κοιματομορφή που ανεβαίνει διότι το pullup μέρος έχει τρανζίστορ πλάτους 800nm και φορτίζει γρηγορά την έξοδο. Ο λόγος  $\beta$ n/ $\beta$ p<1

## Αντιστροφεας με εξοδο Υ2:

nmos: πλάτος 150nm μήκος 60nm

pmos: πλάτος 150nm μήκος 60nm

Εδώ αν το pmos είχε διπλάσιο πλάτος τότε ο λόγος βn/βp θα ήταν ίσο με 1 άλλα παρόλα αυτά είναι πιο κοντά στην μονάδα από την προηγούμενη περίπτωση.

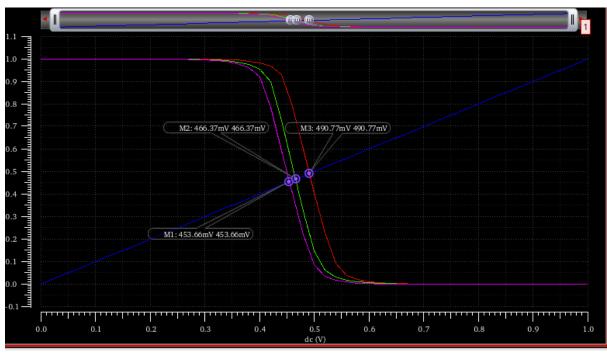
### Αντιστροφεας με έξοδο Υ3:

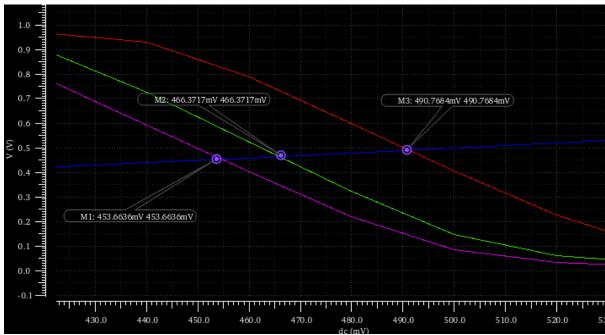
nmos: πλάτος 800nm μήκος 60nm

pmos: πλάτος 400nm μήκος 60nm

Βλέπουμε όταν η τάση εισόδου πάει από 0V στα 1V είναι η πρώτη έξοδος που πέφτει στα 0V διότι στο pulldown μέρος έχουμε τρανζίστορ πλάτους 800nm και η έξοδος αποφορτίζει γρηγορότερα από τους άλλους αντιστροφείς. Ο λόγος βn/βp<1 όπως και στον αντιστροφεα με έξοδο Υ1.

Κοκκινο:εξοδος Υ1 πρασινο:εξοδος Υ2 μοβ: εξοδος Υ3 μπλε:ταση εισοδου

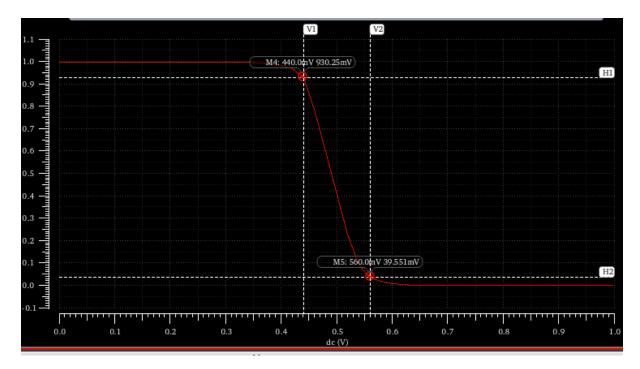




Στα σημεία που έχουμε μαρκάρει η τάση εισόδου = τάση εξόδου.

Περιθώρια θορύβου με πυκνωτή C=1fF

Περιθώρια θορύβου αντιστροφεα με έξοδο Υ1



- $\bullet \qquad V_{IL} = 440,00 mV$
- $V_{IH} = 500,00 \text{mV}$
- $V_{OL} = 39,51 \text{mV}$
- $V_{OH} = 930,25 \text{mV}$

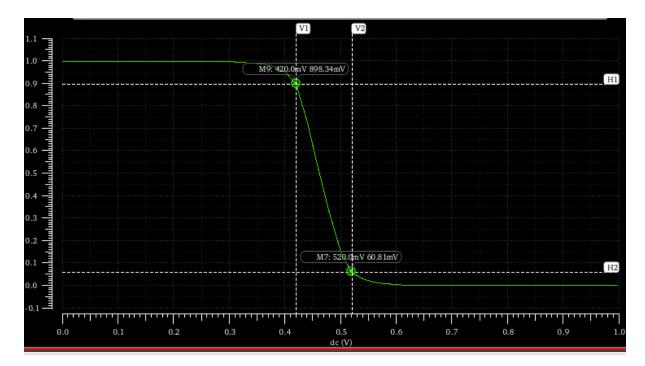
Εύκολα πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τα περιθώρια θορύβου

# Περιθώρια θορύβου

 $NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 930,25 mV - 500,00 mV = 430,25 mV$ 

 $NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 440,00 \text{mV} - 39,51 \text{mV} = 400,49 \text{mV}$ 

Περιθώρια θορύβου αντιστροφεα με έξοδο Υ2



- V<sub>IL</sub> = 420,00mV
- V<sub>IH</sub> = 520,00mV
- V<sub>OL</sub> = 60,81mV
- $V_{OH} = 898,34 Mv$

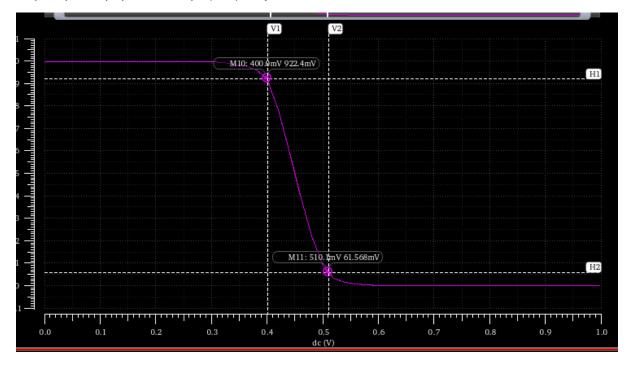
Εύκολα πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τα περιθώρια θορύβου

# Περιθώρια θορύβου

 $NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 898,34 mV - 520,00 mV = 378,34 mV$ 

 $NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 420,00 \text{mV} - 60,81 \text{mV} = 359,19 \text{mV}$ 

### Περιθώρια θορύβου αντιστροφεα με έξοδο Υ3



- $V_{IL} = 400,00 \text{mV}$
- $V_{IH} = 510,10 \text{mV}$
- $V_{OL} = 61,56 \text{mV}$
- $V_{OH} = 922,40 \text{mV}$

Εύκολα πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τα περιθώρια θορύβου

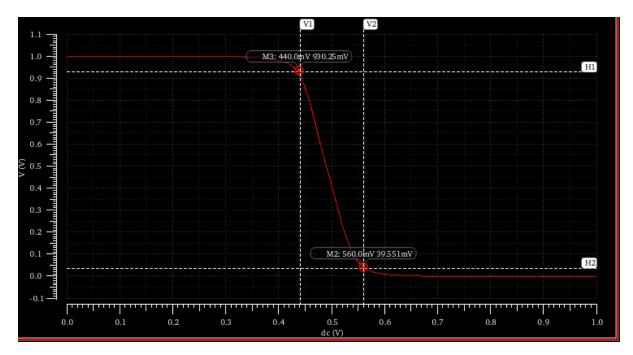
## Περιθώρια θορύβου

 $NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 922,40 \text{mV} - 510,10 \text{mV} = 412,30 \text{mV}$ 

 $NM_L = V_{1L} \text{--} V_{OL} = 400,\!00 \text{mV} \text{ --}61,\!56 \text{mV} = 338,\!44 \text{mV}$ 

# Περιθώρια θορύβου με πυκνωτή C=5fF

Περιθώρια θορύβου αντιστροφεα με έξοδο Υ1



- $\bullet \qquad V_{IL} = 440,00 mV$
- $V_{IH} = 560,00 \text{mV}$
- $V_{OL} = 39,55 \text{mV}$
- $V_{OH} = 930,40 \text{mV}$

Εύκολα πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τα περιθώρια θορύβου

# Περιθώρια θορύβου

$$NM_{H} = V_{OH} \text{--} V_{IH} = 930,40 \text{mV} \text{ --} 560,00 \text{mV} = 370,40 \text{mV}$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 440,00 \text{mV} - 39,55 \text{mV} = 400,45 \text{mV}$$

Περιθώρια θορύβου αντιστροφεα με έξοδο Υ2



- $V_{IL} = 400,00 \text{mV}$
- $V_{IH} = 526,00 \text{mV}$
- $\bullet V_{OL} = 60,81 \text{mV}$
- $V_{OH} = 953,94 \text{mV}$

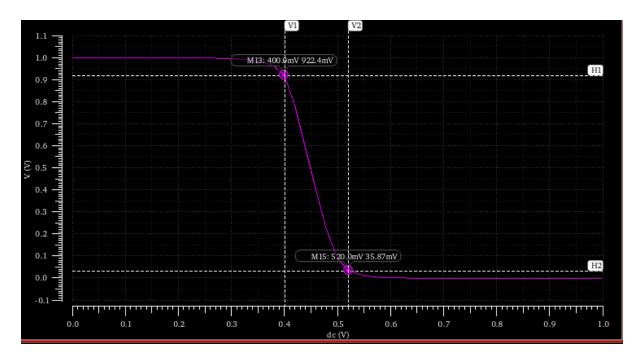
Εύκολα πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τα περιθώρια θορύβου

# Περιθώρια θορύβου

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 953,94 \text{mV} - 526,00 \text{mV} = 427,94 \text{mV}$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 400,00 \text{mV} - 60,81 \text{mV} = 339,19 \text{mV}$$

Περιθώρια θορύβου αντιστροφεα με έξοδο Υ3



- $\bullet \qquad V_{IL} = 400,\!00mV$
- $V_{IH} = 520,00 \text{mV}$
- $V_{OL} = 35,87 \text{mV}$
- $V_{OH} = 922,40 \text{mV}$

Εύκολα πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τα περιθώρια θορύβου

## Περιθώρια θορύβου

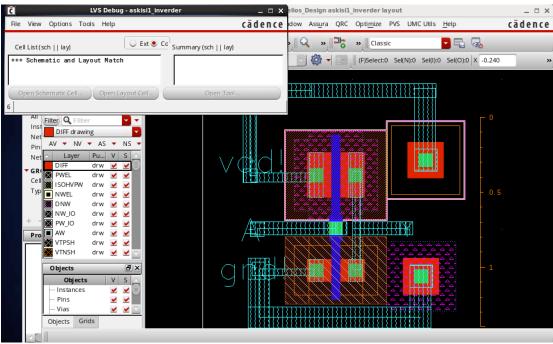
$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 922,40 \text{mV} - 520,00 \text{mV} = 402,40 \text{mV}$$

$$NM_L = V_{IL}$$
- $V_{OL}$  = 400,00mV -35,87mV = 364,13mV

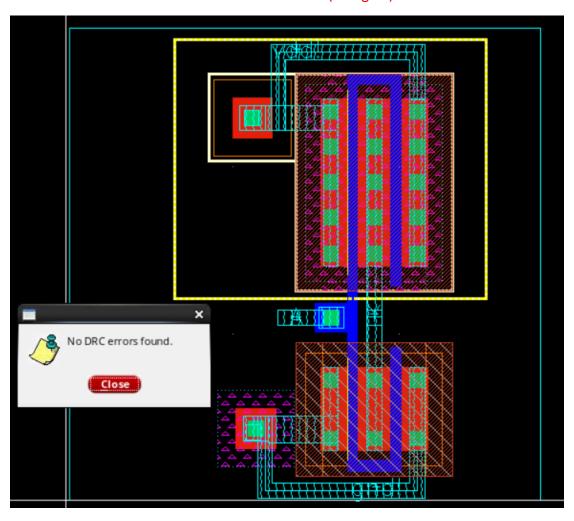
## ΑΣΚΗΣΗ 4

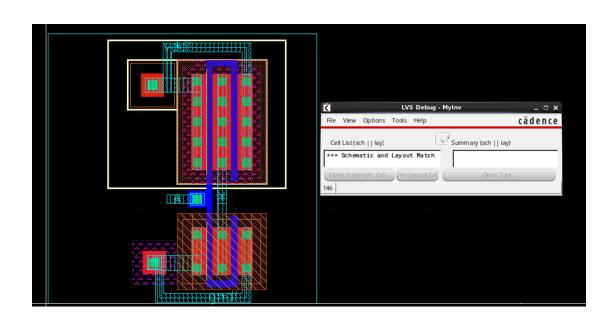
### Inverter1 ΑΣΚΗΣΗΣ 1



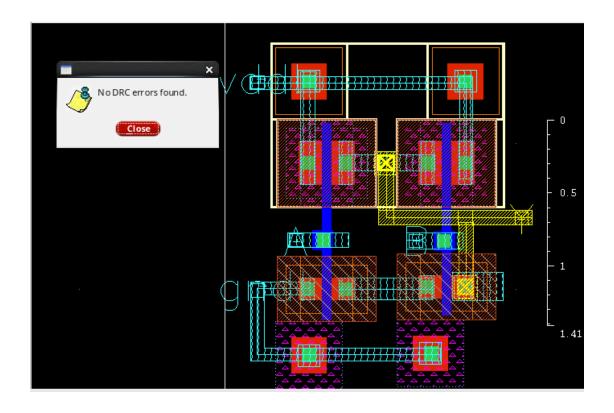


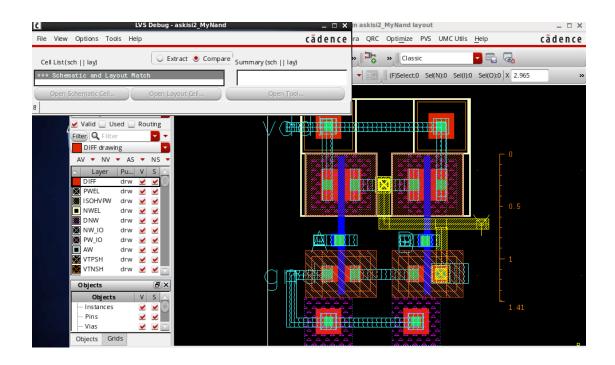
# INVERTER2 ΑΣΚΗΣΗΣ 2(2 fingers)





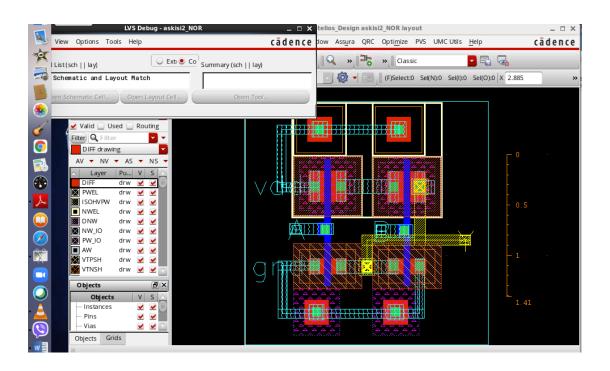
### ΝΑΝΟ ΠΥΛΗ ΑΣΚΗΣΗ 2





#### ΝΟΡ ΠΥΛΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

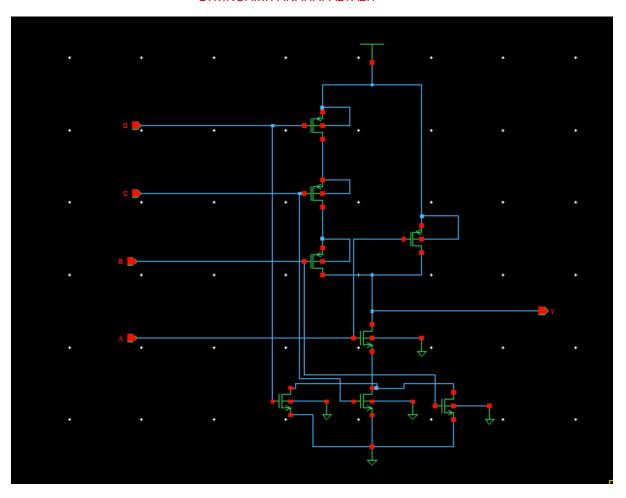




## ΑΣΚΗΣΗ 5

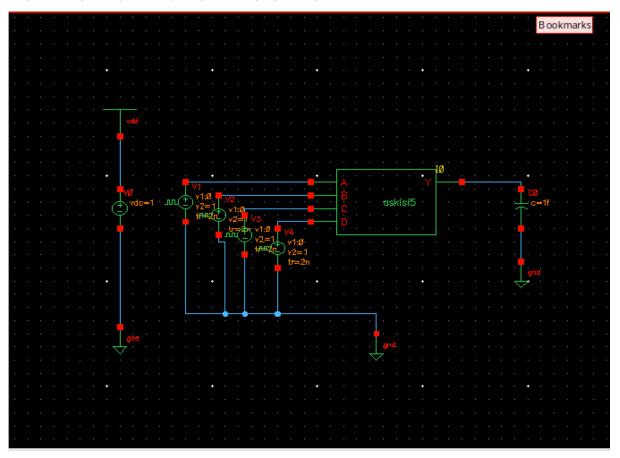
Σε αυτή τη άσκηση καλούμαστε να υλοποιήσουμε την συνάρτηση  $F = (A \cdot (B + C + D)) \text{' με λογική cmos}.$ 

### ΣΥΜΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



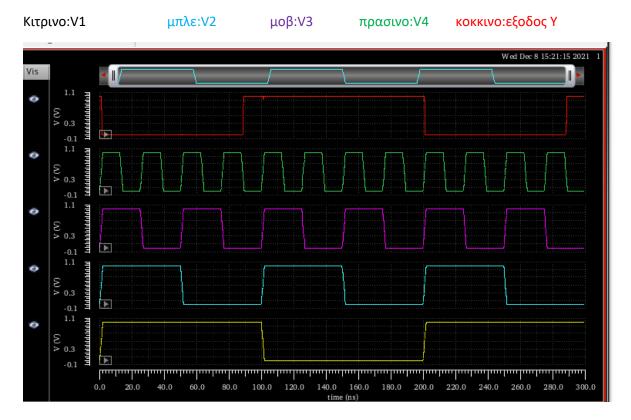
Τέσσερα τρανζίστορ για το pullup και τέσσερα για το pulldown.

Παρουσίαση από symbolic με τις κατάλληλες τάσεις εισόδου.



Για να πάρουμε όλες τις πιθανές εισόδους χρειαστήκαμε 4 παλμοσειρες όπου κάθε μιας είναι υποδιπλασια συχνότητα της άλλης.

# Transient ανάλυση:



### ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΥ

Για να αποφύγουμε την κούραση του αναγνώστη παρουσιάζουμε μετρήσεις μόνο από calculator:

# C=1fF

_ Expression	Value	Expression	Value
1 riseTime(v("/net	319.7E-12	fallTime(v("/net8	289.2E-12

## C=20fF

Expression	Value	Expression	Value
1 riseTime(v("/net	1.439E-9	fallTime(v("/net8	776.7E-12

## C=50fF

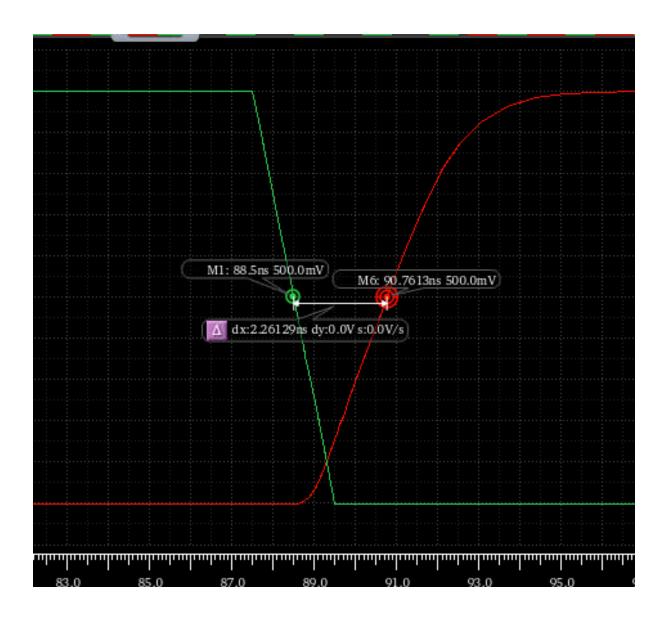
Expression	Value	Expression	Value
1 riseTime(v("/net	3.318E-9	fallTime(v("/net8	1.375E-9

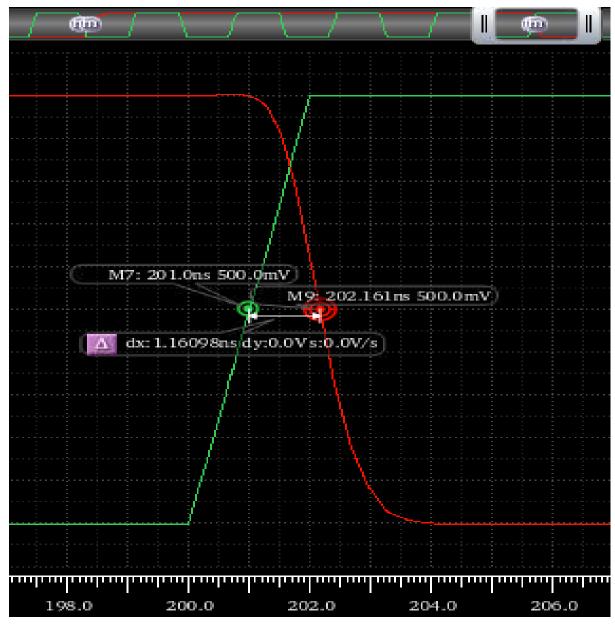
Όπως είναι φυσικό όσο αυξάνουμε την χωρητικότητα εξόδου τόσο αυξάνονται οι χρόνοι risefall.

## Χρονος καθηστερησης διαδοσης

Η ανάλυση έχει γίνει με πυκνωτή 50fF.

Πρασινο εισοδος κόκκινο εξοδοσ





 $T_pLH = 2,2612nsec$ 

 $T_PHL = 1,160$ nsec

Οπότε η μέση καθυστέρηση διάδοσης υπολογίζετε από τον τύπο (TpLH+TpHL)/2 = (2,2612 nsec + 1.160 nsec)/2 = 1,7106 nsec

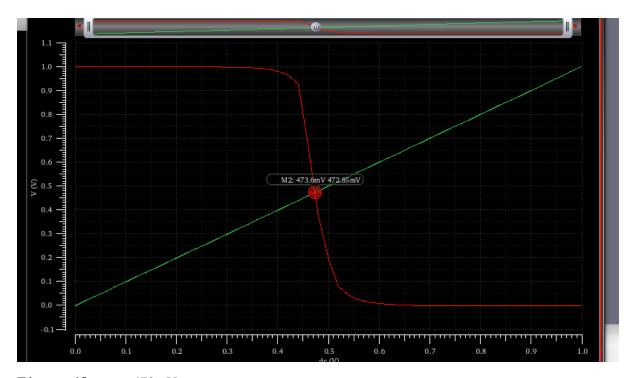
### DC ανάλυση

Στην ανάλυση αυτή θα δούμε την έξοδο συνάρτηση της τάσης εισόδου.

Από την εκφώνηση θέλαμε να δούμε μόνο κατά τις αλλαγές της εισόδου Β.

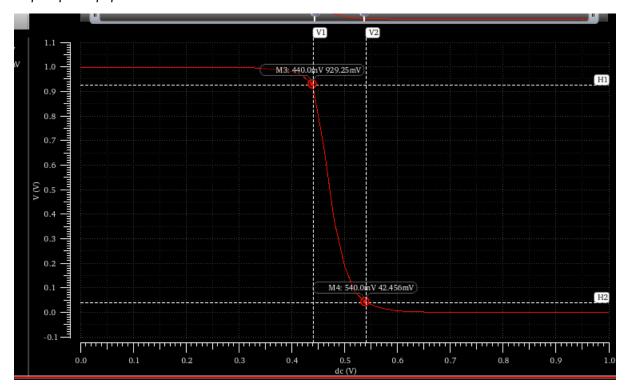
Για να γίνει αυτό εφικτό έπρεπε να βάλουμε τις υπόλοιπες εισόδους σε:

είσοδος A: 1Vείσοδος C: 0Vείσοδος D: 0V



Τάση μετάβασης = 472mV

## Περιθώρια θορύβου:



- $\bullet \qquad V_{IL} = 410,00 mV$
- $V_{IH} = 540,00 \text{mV}$
- $V_{OL} = 42,56 \text{mV}$
- $V_{OH} = 929,25 \text{mV}$

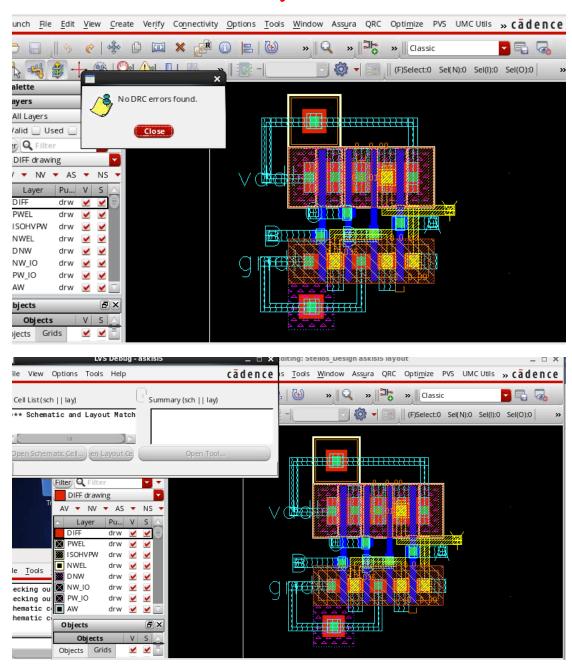
Εύκολα πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τα περιθώρια θορύβου

## Περιθώρια θορύβου

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 929,25 mV - 540,00 mV = 389,25 mV$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 410,00 \text{mV} - 42,56 \text{mV} = 367,49 \text{mV}$$

# Layout



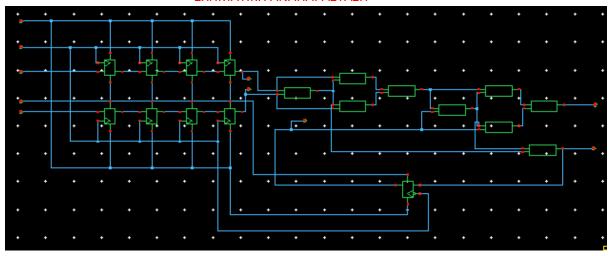
## ΑΣΚΗΣΗ 6

Σε αυτή την άσκηση καλούμαστε να φτιάξουμε το εξής κύκλωμα:

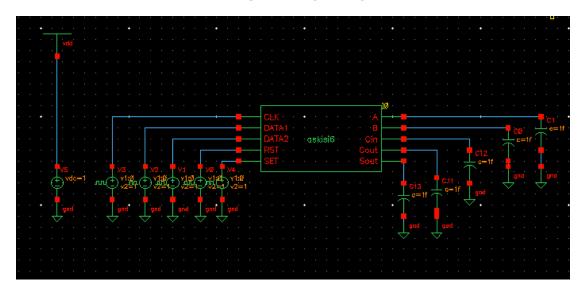
Δυο καταχώρησες (ολίσθησης) των τεσσάρων bit ο καθένας όπου θα

προσθέσουμε τα περιεχόμενα τους. Αυτό το καταφέρνουμε προσθέτοντας τα μπιτ τις ίδιας βαθμίδας κάθε φορά με την βοήθεια ενός full adder και μεταφέροντας αν υπάρχει κρατούμενο στην επόμενη βαθμίδα. Στην αρχή κάνουμε reseat στους καταχωρητές και έπειτα set. Ο full adder υλοποιείτε με 9 πύλες nand όπου τις έχουμε κατασκευάσει σε προηγούμενη άσκηση.

### ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



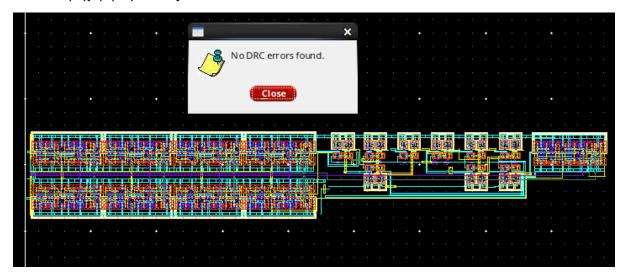
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ TEST BENCH



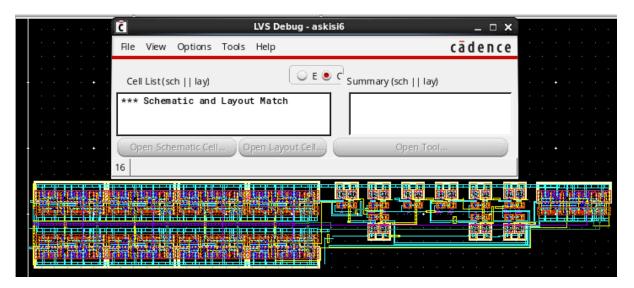
Οι κυματομορφές είναι ίδιες με την ενδεικτική φωτογραφία στο eclass.



Έπειτα προχωρήσαμε σε layout.



Αποτελέσματα DRC:no erors found



Αποτελέσματα LVC:Shematic and Layout Match